

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公開番号】特開2004-238304(P2004-238304A)

【公開日】平成16年8月26日(2004.8.26)

【年通号数】公開・登録公報2004-033

【出願番号】特願2003-27161(P2003-27161)

【国際特許分類第7版】

C 0 7 D 319/06

G 0 3 F 7/004

G 0 3 F 7/039

H 0 1 L 21/027

【F I】

C 0 7 D 319/06

G 0 3 F 7/004 5 0 1

G 0 3 F 7/039 6 0 1

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月15日(2005.4.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

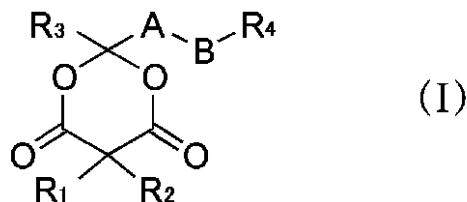
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記一般式(I)で表される化合物。

【化1】



一般式(I)中、

R₁及びR₂は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。R₁とR₂とは、結合して環を形成してもよい。また、R₁とR₂とは、一緒になって二重結合で環と結合する置換基となってもよい。

R₃及びR₄は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

Aは、アルキレン基を表す。

Bは、ヘテロ原子を表す。

【請求項2】

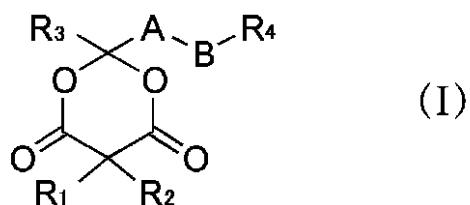
(A)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、

(B)アルカリ現像液に対して不溶性あるいは難溶性であり、酸の作用でアルカリ現像液に可溶性となる樹脂及び

(C)下記一般式(I)で表される化合物

を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化2】



一般式(I)中、

R₁及びR₂は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。R₁とR₂とは、結合して環を形成してもよい。また、R₁とR₂とは、一緒になって二重結合で環と結合する置換基となってもよい。

R₃及びR₄は、同じでも異なっていてもよく、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

Aは、アルキレン基を表す。

Bは、ヘテロ原子を表す。

【請求項3】

請求項2に記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。